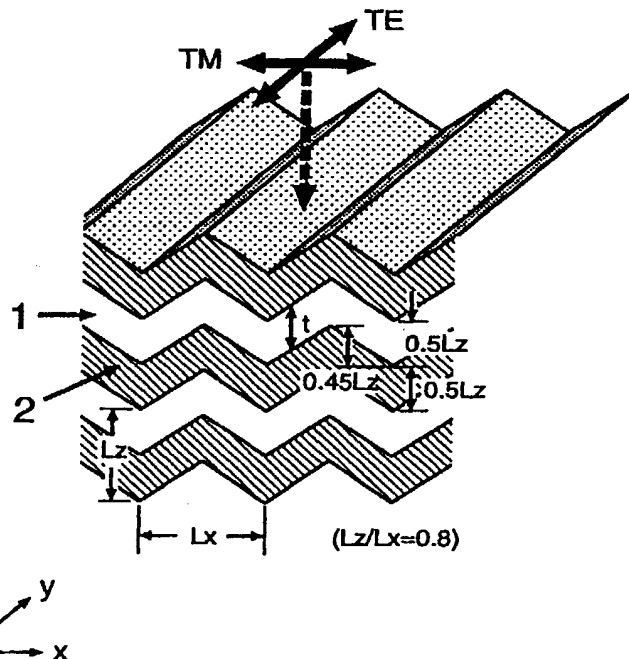




(51) 国際特許分類 G02B 5/30, 5/18	A1	(11) 国際公開番号 WO00/08496  (43) 国際公開日 2000年2月17日(17.02.00)
(21) 国際出願番号 PCT/JP99/04297  (22) 国際出願日 1999年8月9日(09.08.99)  (30) 優先権データ 特願平10/257426 1998年8月7日(07.08.98) JP  (71) 出願人；および (72) 発明者 川上彰二郎(KAWAKAMI, Shojiro)[JP/JP] 〒984-0065 宮城県仙台市若林区土樋236番地 愛宕橋マンションファラオC-09 Miyagi, (JP) (72) 発明者；および (75) 発明者／出願人（米国についてのみ） 大寺康夫(OTERA, Yasuo)[JP/JP] 〒980-0065 宮城県仙台市青葉区土樋1丁目6番15号 コーポ金子201号 Miyagi, (JP) 川嶋貴之(KAWASHIMA, Takayuki)[JP/JP] 〒980-0866 宮城県仙台市青葉区川内三十人町45番5号 ル・ヴィラージュ203号 Miyagi, (JP)		(74) 代理人 弁理士 福森久夫(FUKUMORI, Hisao) 〒102-0074 東京都千代田区九段南4丁目5番11号 富士ビル2F Tokyo, (JP)  (81) 指定国 US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)  添付公開書類 国際調査報告書
(54) Title: POLARIZER  (54) 発明の名称 偏光子  (57) Abstract A polarizer having a two-dimensional periodic structure the period of which is $1\ \mu\text{m}$ or less. The polarizer has a structure in which films of two or more kinds having projections one-dimensionally periodically are built up substantially periodically. The structure is two-dimensionally periodic. The polarizer is made of, for example, two material (1, 2) having different refractive indexes. By a simple method, the two-dimensional periodic structure is fabricated. Incident light having a specific polarization plane is transmitted through the polarizer, and incident light having a polarization plane orthogonal to the specific polarization plane is reflected by the polarizer.		



(57)要約

本発明は、周期が  $1\ \mu\text{m}$  程度ないしはそれ以下の 2 次元周期構造からなる偏光子を提供する。

1 次元的にはほぼ周期的な凹凸を持つ 2 種類以上の膜状物質をほぼ周期的に順次に積層した構造を持つ。2 次元的にはほぼ周期的な構造体から成る。一例として、屈折率の異なる材料 1 と材料 2 とから構成される。

簡単な作成方法により、周期が  $1\ \mu\text{m}$  程度ないしそれ以下の 2 次元周期構造体を得られる。この構造によって、特定の偏波面を持つ入射光を透過させ、それに直交する偏波面を持つ入射光を反射させる偏光子として動作させることができる。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

AE アラブ首長国連邦	DM ドミニカ	KZ カザフスタン	RU ロシア
AL アルバニア	EE エストニア	LC セントルシア	SD スーダン
AM アルメニア	ES スペイン	LI リヒテンシュタイン	SE スウェーデン
AT オーストリア	FI フィンランド	LK スリ・ランカ	SG シンガポール
AU オーストラリア	FR フランス	LR リベリア	SI スロヴェニア
AZ アゼルバイジャン	GA ガボン	LS レソト	SK スロヴァキア
BA ボスニア・ヘルツェゴビナ	GB 英国	LT リトアニア	SL シェラ・レオネ
BB バルバドス	GD グレナダ	LU ルクセンブルグ	SN セネガル
BE ベルギー	GE グルジア	LV ラトヴィア	SZ スワジランド
BF ブルキナ・ファソ	GH ガーナ	MA モロッコ	TD チャード
BG ブルガリア	GM ガンビア	MC モナコ	TG トーゴ
BJ ベナン	GN ギニア	MD モルドヴァ	TJ タジキスタン
BR ブラジル	GW ギニア・ビサウ	MG マダガスカル	TZ タンザニア
BY ベラルーシ	GR ギリシャ	MK マケドニア旧ユーゴスラヴィア	TM トルクメニスタン
CA カナダ	HR クロアチア	共和国	TR トルコ
CF 中央アフリカ	HU ハンガリー	ML マリ	TT トリニダード・トバゴ
CG コンゴ	ID インドネシア	MN モンゴル	UA ウクライナ
CH スイス	IE アイルランド	MR モリタニア	UG ウガンダ
CI コートジボアール	IL イスラエル	MW マラウイ	US 米国
CM カメルーン	IN インド	MX メキシコ	UZ ウズベキスタン
CN 中国	IS アイスランド	NE ニジェール	VN ヴイエトナム
CR コスタ・リカ	IT イタリア	NL オランダ	YU ユーゴスラビア
CU キューバ	JP 日本	NO ノールウエー	ZA 南アフリカ共和国
CY キプロス	KE ケニア	NZ ニュー・ジールランド	ZW ジンバブエ
CZ チェッコ	KG キルギスタン	PL ポーランド	
DE ドイツ	KP 北朝鮮	PT ポルトガル	
DK デンマーク	KR 韓国	RO ルーマニア	

## 明細書

## 偏光子

## 5 技術分野

本発明は、光の特質である偏光現象を利用した光学機器に用いられ、特定方向の直線偏光のみを透過させ直交する方向の直線偏波を反射させる偏光子に関する。

## 10 背景技術

偏光子とは、不特定の方向に電磁界が振動する無偏光または楕円偏光を、ある特定方向の振動成分だけを透過させて直線偏光にする素子である。最も基本的な光素子の一つであり、光通信デバイス、光ディスクのピックアップ、液晶ディスプレイ、光応用計測など広く利用されている。動作形態は、(1) 不要な偏波を吸収させるもの、(2) 同一の光路で入射する直交する二つの偏波成分を別々の光路に分けるもの、の二つに大別される。利用目的により、大きな開口面積、高性能、薄型などの特性を実現することが望まれており、産業的には安価に供給できることが重要である。

現在、実用的に使用されている偏光子は、(1) の動作をするものでは高分子フィルムにヨウ素などの二色性分子を入れたものが一般的である。これは安価で大面積のものが得られるが、消光比が低く、温度安定性に劣るという欠点がある。

この問題を解決するため、安定性の高い材料を用いた偏光子が開発されている。即ち、ガラスなどの透明体の中に金属や半導体などの吸収体を、細線状あるいは薄膜状に一方向に配列したものである。細線あるいは薄膜に平行な偏波成分は吸収あるいは反射され、それに直交する偏波は透過する。この種の偏光子は消光比が高く取れるのが特徴であるが、切断・研磨などの工程が必要となり、製造コストの低減が困難である。また大面積で且つ薄型にすることは困難である。

一方、(2)に複屈折単結晶を用いたものは、方解石など複屈折率の大きい材料からなる三角プリズムを2個貼り付けた構造をしている。代表的なものにはグラントムソンプリズムがある。この種の偏光子は一般に高い消光比、高い透過率が得られるが、大面積や薄型にすることが困難であり、材料が高価であるため価格も必然的に高くなる。

透明体のブリュースター角を利用したものでは、誘電体多層膜を用いた偏光ビームスプリッタが挙げられる。これは量産性に富むため低価格ではあるが、高い偏光度は得られない、小型化も困難である、使用波長帯域が狭い、などの問題点があり、限られた用途にしか使用されていない。

- 10 上述の各偏光子はそれぞれ実用されているが、一方、最近になって波長以下の周期をもつ透明体周期構造の伝搬特性の異方性を利用した偏光子が理論的に提案されている(浜野哲子, 井筒雅之, 平山秀樹, "2次元フォトニック結晶を用いた偏光子の可能性," 第58回応物秋季予稿集, paper2a-W-7, 1997., 佐藤晃, 竹部雅博, "構造的複屈折による光学異方性多層膜," Optics Japan '97, 講演予稿集, paper30pD01, 1997)。これらの構造は、いずれも透明母材中に、母材と屈折率の異なる透明体の細柱を2次元周期的に配列させたものである。周期が例えば半波長程度という条件を満たす構造であれば、柱に平行な偏波と垂直な偏波に対して、一方は内部を伝搬させ、他方は遮断させることができ、従って偏光子として動作させられる。しかし、実際にはこのような構造を工業的に作製する方法は見つかっていないし、実験例もない。

本発明は上記の問題点を解決するためのものであり、本発明の目的は、小さい光路長で、優れた消光比と挿入損失特性を有し、大きな開口面積も可能な、低価格の工業的に作製できる偏光子を提供することにある。

## 25 発明の開示

本発明の偏光子の背景となる技術について説明する。高屈折率媒質と低屈折率媒質からなる人工的な周期構造において、互いに直交する二つの偏波成分は、それぞれが独立な分散関係(周波数と波動ベクトルとの間の関係)を持っている。この二つの偏波成分は、本発明に関連の深い2次元周期構造では電界または磁

界のいずれが長さの方向に平行であるかによってそれぞれTE波、TM波である。また一般の3次元周期構造でも固有モードはTE的な波とTM的な波に通常分類される。故に本発明においては便宜上TE波、TM波と呼ぶことにする。バンドギャップ、すなわち光が伝搬しない周波数帯域もTE波とTM波では異なる。ある周波数帯域において、一方の偏光モードが遮断され、他方の偏光モードが伝搬波となる場合がある。即ち、この周波数帯域においては、この周期構造体は一方の偏光を反射または回折し、他方の偏光を透過させる偏光子としての動作が可能である。また、消光比も周期数の増加によって十分高いものが得られる。

- 10 本発明の中心思想は、屈折率の異なる2種類以上の透明体からなり、3次元の直交座標系  $x y z$  において、積層の単位となる層の形状が  $x$  軸方向に周期構造を有し、 $y$  軸方向には一様であるか、または  $x$  軸方向より長い周期をもつ構造を有し、その形状を繰り返しつつ  $z$  軸方向に層状に積層されている構造、即ち、周期的なひだ(うねり)を有する二種類以上の薄膜を多層化した構造において
- 15 て面型偏光子の特性が存在することを発見したこと、およびその構造を発明者らが開発してきた周期構造作製方法により作製する方法を発明したことである。光は面に垂直あるいは斜めに入射される。開口面積は基板の大きさで決まり、大きくすることは極めて容易である。また光路長は積層厚さで決るが、波長の数倍程度(数  $\mu m$ )で十分であり、従来の偏光子に比べて数桁単位で薄くすることができる。
- 20

- 一方、バイアス・スパッタリングに代表される堆積粒子の拡散入射とスパッタエッチングを併用した成膜法において、その堆積作用とエッチング作用を相互に制御することにより、表面の凹凸形状を繰り返しつつ層状に積層させる方法が可能である。このメカニズムは次の3つの効果、(1)堆積粒子の拡散入射
- 25 により影となる凹部の堆積速度が遅くなる効果、(2)スパッタエッチングによる傾斜角約  $50^\circ$  から  $60^\circ$  の面においてエッチング速度が最大になる効果、(3)主にスパッタエッチングにより削られた粒子が基板の別の場所に再付着する効果、の適切な割合での重ね合せであると説明ができる(川上彰二郎, 佐藤尚, 川嶋貴之, "バイアススパッタ法で作製される3D周期ナノ構造の形成機構,

“電子情報通信学会誌 C-I, vol. J81-C-I, no. 2, pp. 108 - 109, 1998 年 2 月)。

- この技術を用いることで、周期的な溝列を形成した基板上に、二種類の透明材料からなる薄膜を煩雑な位置合わせを一切行わずに位置の等しい凹凸形状を繰り返しつつ周期的に積層することができる。即ち、この技術を用いることで本発明の偏光子を容易に作製することができる。

以上のことから、本発明の偏光子は、小さい光路長で、優れた消光比と挿入損失特性を有し、大きな開口面積も可能で、低価格で提供することができる。

#### 図面の簡単な説明

- 10 図 1 は、第 1 の実施例の構造を示す図である。  
図 2 は、表面に溝を有する基板を示す図である。  
図 3 a は、TE 波に対する透過光の近視野における強度分布を示す図である。  
図 3 b は、TM 波に対する透過光の近視野における強度分布を示す図である。  
図 4 は、第 2 の実施例における周波数と波動ベクトルの関係を示す図である。  
15 図 5 は、第 2 の実施例の構造を示す図である。  
図 6 は、第 2 の実施例における周波数と波動ベクトルの関係を示す図である。

#### (符号説明)

- 1 SiO<sub>2</sub> 層、  
2 Si 層、  
20 3 基板、  
4 無反射コーティング層、  
5 周期的な溝、  
6 TM 波を透過させる偏光子として作用する周波数帯のひとつ、  
7 SiO<sub>2</sub> 層、  
25 8 Si 層、

#### 発明を実施するための最良の形態

図 1 は、本発明の偏光子の構造を示している。以下に図 1 を用いて本発明の偏光子を説明する。

周期的な溝あるいは線状突起列に、透明で高屈折率の媒質と低屈折率の媒質とを界面の形状を保存しながら、交互に積層する。x方向とz方向に周期性があり、y方向には本実施例では一様な構造である。あるいは、x軸方向より大きい長さの周期的または非周期的な構造に変更しても動作機構は類似している。

- 5 このようにして得られた周期構造体にz方向から無偏波光または楕円偏光を入射する。溝列と平行な偏波即ちy偏波と、それに直交する偏波即ちx偏波とに対して、TEモード、TMモードの光が周期構造体の内部に誘起される。しかし、光の周波数が、TEモードまたはTMモードのバンドギャップの中にあれば、そのモードは周期構造体の中で伝搬することができず、入射光は反射または回折される。一方、光の周波数がエネルギーバンド内にあれば、周期構造体の中を光は波動ベクトルを保存しながら透過する。従って面型の偏光子として動作する。
- 10

- 本発明の偏光子では、溝列の周期 $L_x$ 、積層方向の周期 $L_z$ を制御することで、TEモード、TMモードのバンドギャップが生じる波長帯域を任意に変えることができる。即ち偏光子として動作させる波長帯域を任意に設定することが可能である。
- 15

- また低屈折率媒質としては $\text{SiO}_2$ を主成分とする材料が最も一般的である。 $\text{SiO}_2$ は透明波長領域が広く、化学的、熱的、機械的にも安定であり、成膜も容易に行なえる。高屈折率材料としては、 $\text{TiO}_2$ などの酸化物や、 $\text{Si}$ 、 $\text{GaAs}$ などの半導体が使用できる。 $\text{TiO}_2$ などは透明波長範囲が広く、可視光領域でも使用できる。一方、半導体は、近赤外域に限定されるが、屈折率が大きい利点がある。
- 20

- ところで、多目的の偏光子としては、広い周波数帯域で、使用することが望ましい。高屈折率媒質層と低屈折率媒質層の形状を適切に決定することにより、偏光子としての使用周波数帯域を広くとることができる。逆に、特定のレーザー光のような単色の光に対しては、高屈折率媒質と低屈折率媒質の形状に対する自由度は大きく、成膜において、繰り返しが容易な形状を選択することができる。
- 25

以下、実施例において、層の形状と繰り返し構造および、その作製方法を示

す。

(実施例 1)

図 1 は、本発明の実施例の構造を示す図である。この図において、符号 1 はアモルファス  $\text{SiO}_2$  の層であり、符号 2 はアモルファス  $\text{Si}$  の層である。x 軸方向の周期  $L_x$  は  $0.4 \mu\text{m}$ 、z 軸方向の周期  $L_z$  は  $0.32 \mu\text{m}$  である。  
5  $\text{SiO}_2$  層および  $\text{Si}$  層は厚さ  $t$  をわずかに変化させながら、周期的に折れ曲がった形状をなしている。次に、その作製方法を説明する。まず、基板上に電子ビームリソグラフィとドライエッチングにより周期的な溝を作製した。図 2 が、その模式図である。符号 3 は石英ガラス基板、符号 4 は無反射コーティング層、符号 5 は周期的な溝の部分である。一般には周期構造の寸法を選択により、4、5 は基板と異なる材料から選定するが、基板と同一の材料のままその上に溝を形成することもできる。ここでは後者の例を示す。溝の幅は  $0.4 \mu\text{m}$ 、深さは  $0.2 \mu\text{m}$ 、横方向の周期は  $0.4 \mu\text{m}$  である。この基板上に、 $\text{SiO}_2$  および  $\text{Si}$  のターゲットを用い、バイアス・スパッタリング法により、  
10  $\text{SiO}_2$  層と  $\text{Si}$  層を交互に積層した。そのとき、各層の x 軸方向に周期的な凹凸の形状を保存しながら成膜を行なうことが肝要である。その条件は次のとおりであった： $\text{SiO}_2$  の成膜に対しては、 $\text{Ar}$  ガス圧  $1.9 \text{mTorr}$ 、ターゲット高周波電力  $400 \text{W}$ 、基板高周波電力  $60 \text{W}$ ； $\text{Si}$  の成膜に対し、 $\text{Ar}$  ガス圧  $3.6 \text{mTorr}$ 、ターゲット高周波電力  $400 \text{W}$  であった。 $\text{SiO}_2$  と  $\text{Si}$  の層を、10 層ずつ堆積した。  
20

この条件において、図 2 に示された矩形の溝を有する基板の上に、図 1 に示された積層構造が生成される理由は、次に述べる 3 要素の重ね合わせによって説明することができる：(1) ターゲットからの中性粒子の分散入射による堆積；(2)  $\text{Ar}$  イオンの垂直入射によるスパッタエッチング；(3) 堆積粒子の再付着である。  
25

図 3 a と図 3 b は、このようにして得られた周期構造体における、波長  $1.0 \mu\text{m}$  での TE 波と TM 波に対する透過光の近視野での強度分布を示す図である。横軸は基板ウエハ上の位置を示す。中央部分が偏光子部分であって、その両側は、基板ウエハーが溝を持たず、 $\text{Si}$  と  $\text{SiO}_2$  の平行層が堆積された部



分である。縦軸は、基板ウェハー上の各点における透過光強度である。偏光子部分はTE波をほとんど遮断していることがわかる。一方、TM波に対しては、両側の溝がない基板上に堆積された膜の部分と偏光子部分において、透過光強度の差は微小である。言い換えると、偏光子部分に無反射コーティングを施せば、微小な損失で、TM波を透過させることができる。

図4に、この周期構造体における周波数と波動ベクトルの関係を周期的境界条件を用いたFDTD法（有限差分時間領域法）により計算した結果を示す。FDTD法によるフォトニック結晶のバンド構造と光透過特性の解析はS. Fanらにより、Physical Review B, vol. 54, no. 16, pp. 11245-11251 (1996 年)において報告されているとおりである。図4において、横軸は相対値で表した波動ベクトルの大きさであり、縦軸は相対値で表した周波数 $L_x/\lambda$ である。ここで、 $\lambda$ は入射光の波長、 $k_z$ は波動ベクトルの $z$ 成分である。実線と破線は、それぞれTE波とTM波における分散曲線を示す。ここで $L_x = 0.4 \mu\text{m}$ 、波長 $1 \mu\text{m}$ より、周波数 $L_x/\lambda = 0.4$ となる。この図からわかるように、 $L_x/\lambda = 0.4$ の直線はTE波の分散曲線（実線）とは交わらず、TM波の分散曲線（破線）とは交わる。これはTE波は遮断・反射され、TM波は透過することを意味する。すなわち、この周期構造体は周波数 $L_x/\lambda$ が0.39から0.43の間に位置する符号6の周波数帯でTM波を透過させる偏光子として作用している。

## 20 (実施例2)

本実施例では、各誘電帯の層の厚さの面内均一性や溝の形状、 $L_z/L_x$ の比の値などのパラメータが実施例1に示すものから変化しても優れた偏光子特性が得られることを例示する。

図5は、本発明の他の実施例の構成を示す図である。符号7はアモルファス $\text{SiO}_2$ 層であり、符号8はアモルファスSi層である。 $x$ 軸方向の周期 $L_x$ は $0.4 \mu\text{m}$ 、 $z$ 軸方向の周期 $L_z$ は $0.32 \mu\text{m}$ である。 $\text{SiO}_2$ 層は厚さ $t$ を $0.9 L_z$ と $0.3 L_z$ の間で変化させながら、そして、Si層は厚さを $0.1 L_z$ と $0.7 L_z$ の間で変化させながら、周期的に折れ曲がった形状をなしている。積層膜の作製において、基板は実施例1の場合と同じであるが、

S i O<sub>2</sub>層およびS i層を生成するバイアス・スパッタリングの条件が異なっている。

この周期構造体における周波数と波動ベクトルの関係をFDTD法により、計算した結果を図6に示す。横軸は相対値で表した波動ベクトルの大きさであり、縦軸は相対値で表した周波数である。実線と破線は、それぞれTE波とTM波における分散曲線である。この図からわかるように、第1の実施例の場合よりも、偏光子として作用する周波数帯が広がっている。ところで、ひとつのバンドギャップに着目したとき、単一の光周波数で使用する偏光子に対して、その周波数幅は広いことが望ましい。なぜなら、バンドギャップの端から十分に離れていない周波数においては、消光比を大きくとるために必要なz方向の周期数が増大するからである。

第1と第2の実施例において、z軸方向とx軸方向の繰り返し周期の比 $L_z/L_x$ は0.8であったが、FDTD法による他の計算結果から0.2程度であっても、偏光子としての作用が可能であることがわかっている。またx方向の周期 $L_x$ は、通常の偏光子として使用する場合には、光の波長以下程度に選ばれるが、一方の偏光をまっすぐに透過させ、他方の偏光を回折させるための偏光素子においては、光の波長よりも長い周期 $L_x$ を選択するとよいことがわかっている。さらに、溝はy軸方向に必ずしも一様である必要はなく、x軸方向の溝の幅と間隔に対して、異なる周期構造を持っていたとしてもよく、あるいはy方向に充分長いランダムな長さの溝であってもよいことが、他の計算の結果、わかっている。

ところで、今回は、単位となる層の形状を繰り返しつつ積層する手段として、バイアス・スパッタリング法を用いたが、堆積プロセスとスパッタリングエッチングのプロセスを同時でなく時間的に分離した方法を加えることにより、積層の単位となる層の形状の設計自由度を大きくとることができる。さらに、低屈折率媒質としては、アモルファスS i O<sub>2</sub>以外にも、パイレックスなどの光学ガラスを用いることができる。一方、高屈折率媒質としてはS i以外にも、T i O<sub>2</sub>、T a<sub>2</sub>O<sub>5</sub>などを用いることもできる。基板の溝の断面形状は、今回、V形であったが、矩形の溝であってもよいことは明らかである。また、バイア

ス・スパッタリングの条件を適切に選択すれば、多様な溝の断面形状が可能である。

- このようにして作製した積層膜を偏光子として使用するためには、表面と基板の反対側の面に無反射コーティングを施した後、切断すればよい。多数の素子を一括して作製できるだけでなく、研磨が不要であり、切断工程が簡易である。その結果、低価格の偏光子を提供することができる。また、基板を除く積層膜の厚さは数ミクロンであり、垂直入射または小さい入射角での使用が可能である。それゆえ、小型の光通信用アイソレータなどへの、広範な応用が可能である。また、光サーキュレータなどに用いる偏光分離素子として使用するときには、入射光に対して大きく傾けて使用する場合があるが、この場合も切断面を光が透過することはないので、研磨が不要である。

#### 産業上の利用可能性

- 本発明のスパッタリングエッチング作用を含む成膜方法によって作製した偏光子は、光透過方向の厚さが微小で、1回の成膜プロセスで大面積の積層膜が得られ、個々の素子を作製するときに、研磨が不要であり、切断が容易であるという特徴を備えている。他方、使用する波長域に応じて、優れた偏光特性を持たせる設計が可能である。このような偏光子は、光アイソレータ用の偏光子として最適である。他にも光サーキュレータ、光スイッチなど工業的用途は広く、従来の偏光子を置き換えることが可能である。

10  
請求の範囲

1. 3次元の直交座標  $x$ ,  $y$ ,  $z$  において、屈折率の異なる2種類以上の透明体よりなる  $z$  軸方向の多層構造体であって、各透明体ごとに積層の単位となる層の形状が  $x$  軸方向に周期凹凸構造を有し、 $y$  軸方向には一様であるか、または  $x$  軸方向より大きい長さの周期的または非周期的な凹凸構造を有し、その形状を周期ごとに繰り返しつつ  $z$  軸方向に層状に積層されていて、入射方向が  $z$  軸方向に零でない成分を持つ光に対して作用することを特徴とする偏光子。
2. 請求項1記載の偏光子であって、 $\text{Si}$  または  $\text{TiO}_2$  を主成分とする高屈折率媒質と  $\text{SiO}_2$  を主成分とする低屈折率媒質層を有する偏光子。
3. 周期的な溝または周期的な線状突起または細長い突起または細長い凹みを有する基板の上に、高屈折率媒質と低屈折率媒質とを、少なくとも一部にドライエッチングを含む膜形成方法により周期ごとに形状を繰り返しつつ積層することで作製された偏光子。
4. 周期的な溝または周期的な線状突起または細長い突起または細長い凹みを有する基板の上に、 $\text{Si}$  または  $\text{TiO}_2$  を主成分とする高屈折率媒質と  $\text{SiO}_2$  を主成分とする低屈折率媒質とを、少なくとも一部にドライエッチングを含む膜形成方法により周期ごとに形状を繰り返しつつ積層することで作製された偏光子。

Fig.1

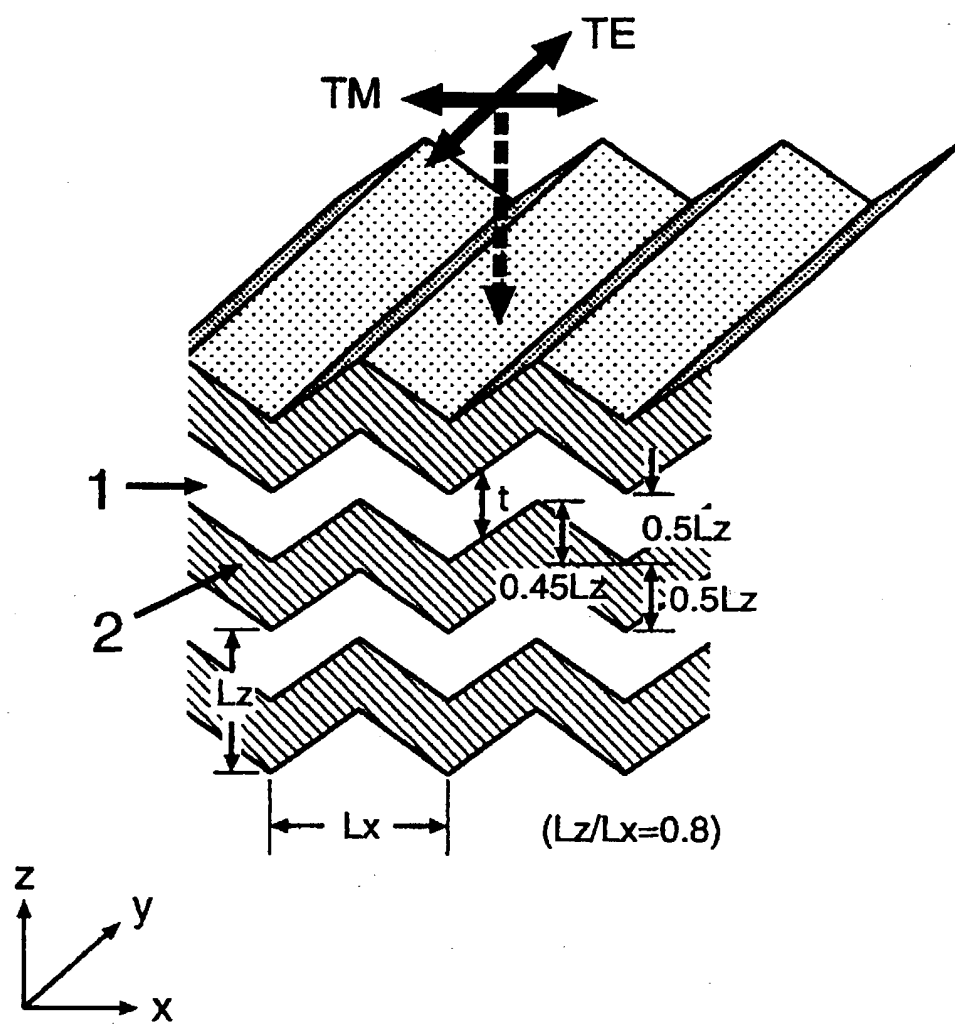
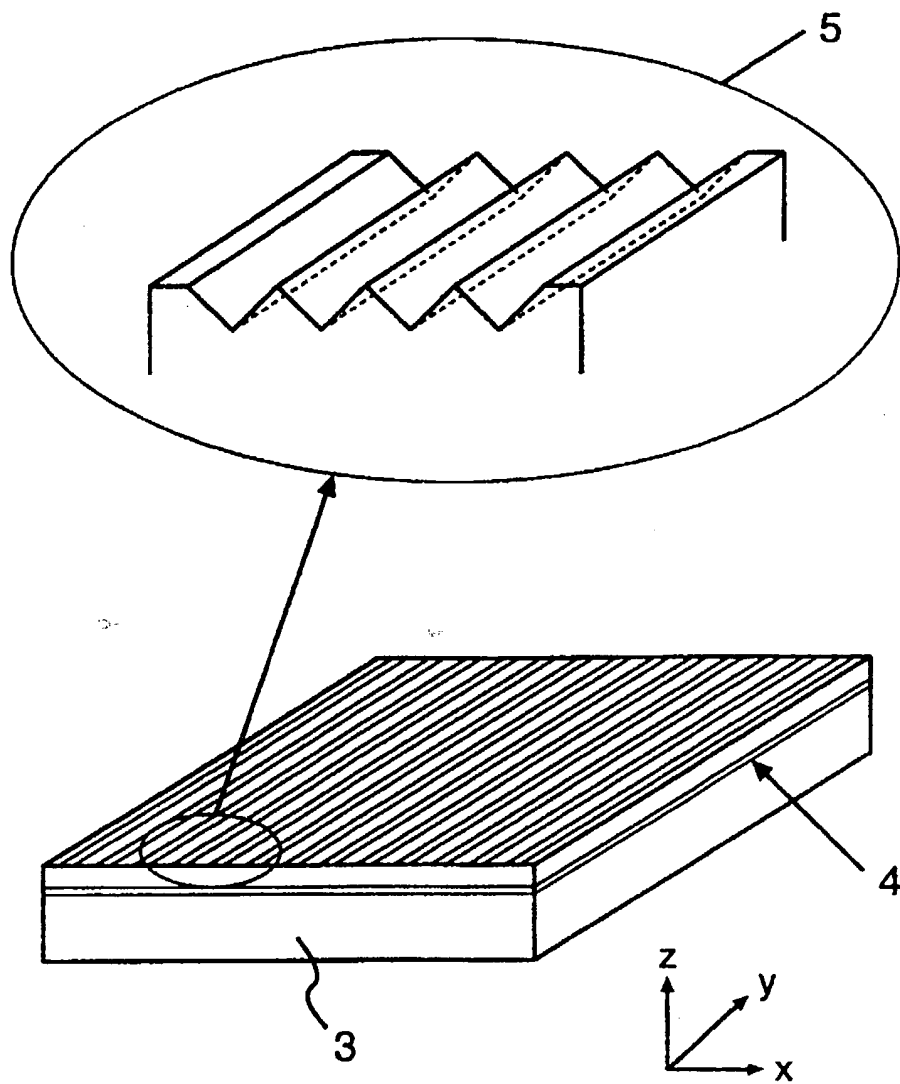
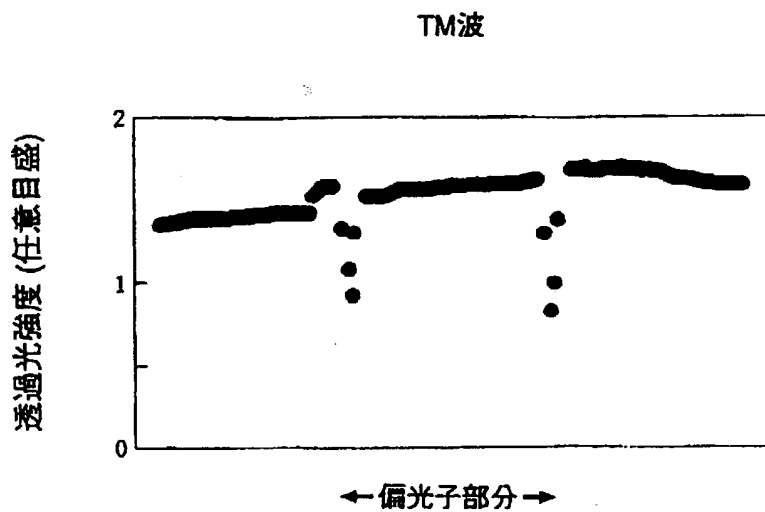
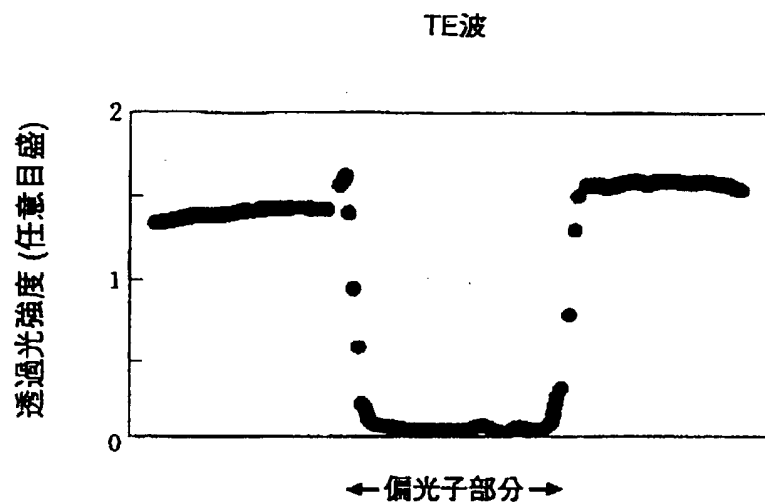


Fig.2



3/6

Fig.3



ウェハー上の位置

Fig. 4

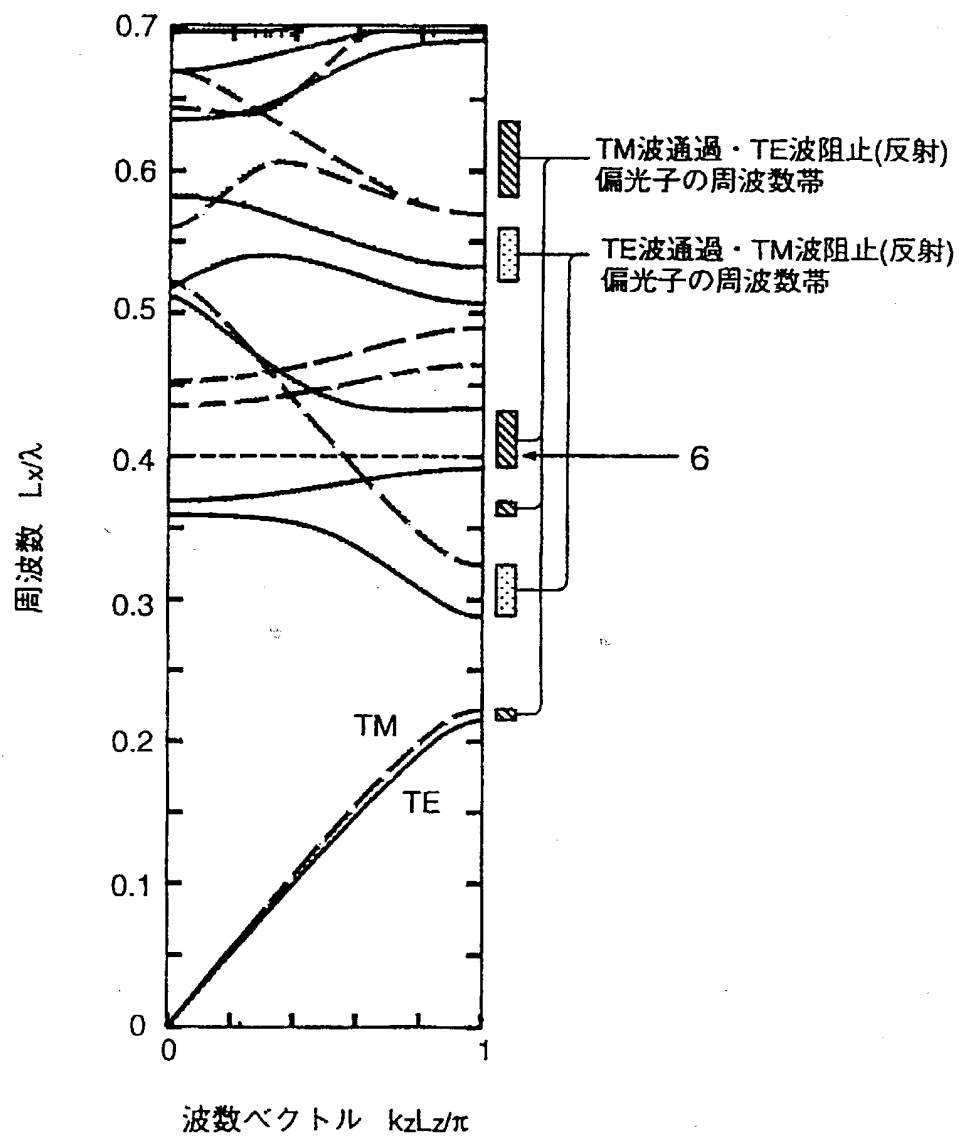




Fig.5

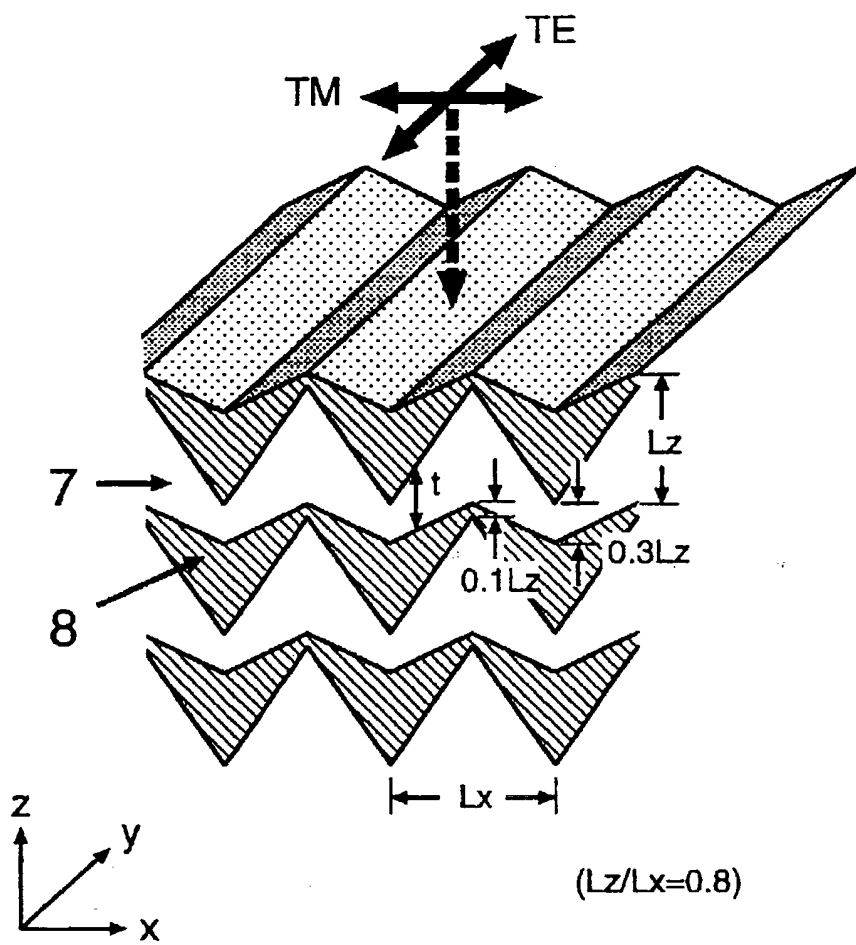
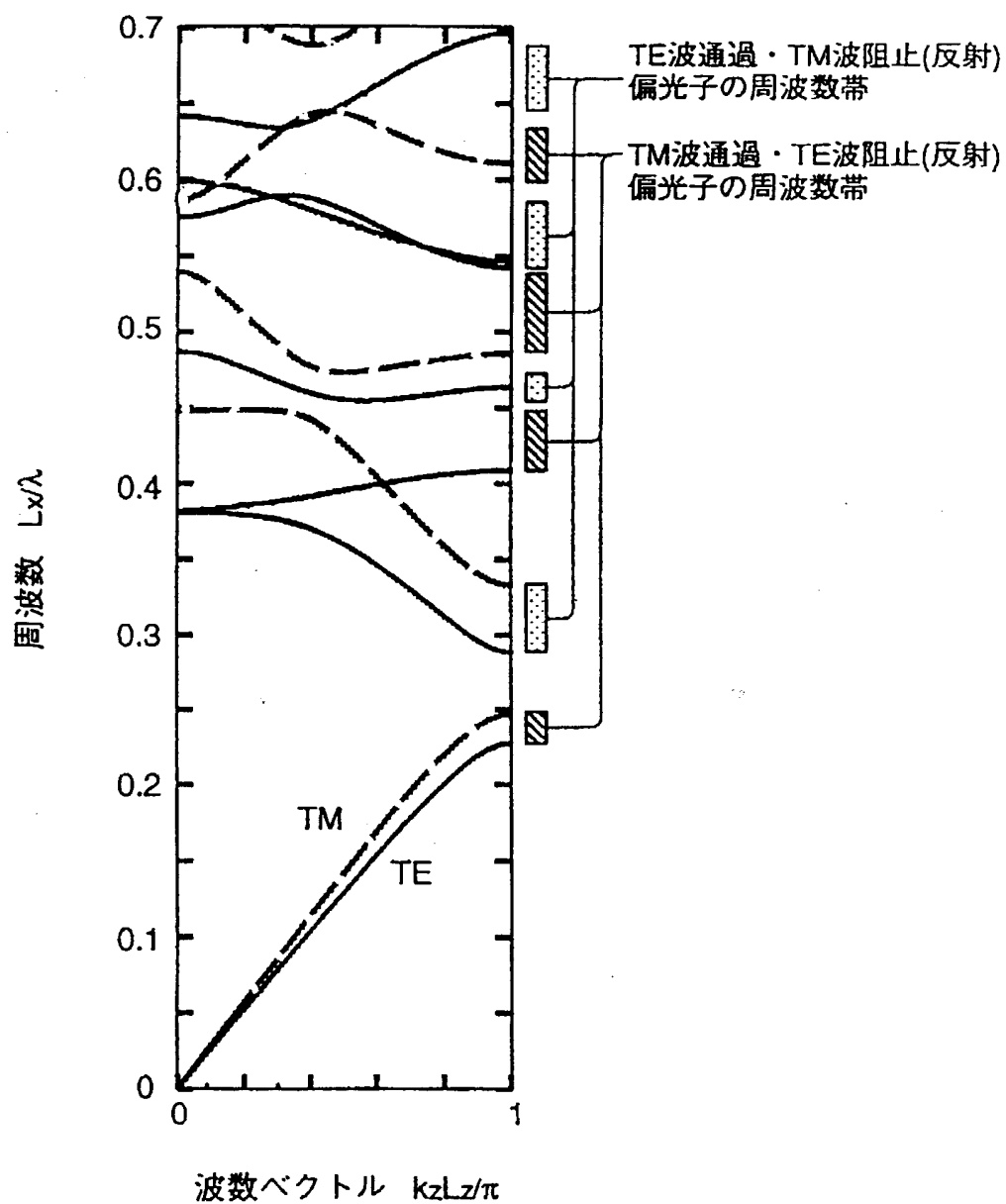


Fig. 6



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP99/04297

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER  
Int. Cl.<sup>6</sup> G02B5/30, G02B5/18

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int. Cl.<sup>6</sup> G02B5/30, G02B5/18

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched  
Jitsuyo Shinan Koho 1926-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-1999  
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-1999 Jitsuyo SHINAN Toroku Koho 1996-1999

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	Extended Abstracts (The 58 <sup>th</sup> Autumn Meeting, 1997); The Japan Society Of Applied Physics (October 1997), Tetsuko Hamano, Masayuki Ito, Hideki Hirayama, "Possibility of polarizer using 2D photonic crystals" paper 2a-W-7 (p.993)	1-4
Y	The Transactions of The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers C-II, Vol.J80-C-II No. 6, (June 1997) Shojiro Kawakami et al., "Fabrication and observation of 3D photonic crystals composed of Si/SiO <sub>2</sub> with Sub-Micrometer periods" p.222-223	1-4
Y	JP, 9-304611, A (Oki Electric Ind. Co., Ltd.), 28 November, 1997 (28.11.97), Full text; all drawings (Family: none)	1-4
Y	J. Vac. Sci. Technol. B Vol. 15, No. 6, Nov/Dec 1997, Chuan C. Chang, Axcel Scherer, Ron-Chung Tyan, Yeshayahu Fainman, George Witzgall, Eli Yablonovitch "New fabrication techniques for high quality photonic crystals" p.2764-2767, especially p.2764, right column, line 7 to p.2765, left column, line 5; fig. 1. in-plane 2D structure; P.2766, left column, line 31 to right column, line 5, Fig.4	1-4

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier document but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search  
01 November, 1999 (01.11.99)

Date of mailing of the international search report  
16 November, 1999 (16.11.99)

Name and mailing address of the ISA/  
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP99/04297

## C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	The Transactions of The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers C-I, Vol. J81-C-I No. 2, (February 1998) Shojiro Kawakami et al., "Mechanism of Shape-Formation for 3D Periodic Nanostructures by Bias Sputtering" p.108-109	1-4
P,X	Kagaku Kogyo (January 1999), Osamu Hanaizumi, Shojiro Kawakami, "Photonic Crystals and those application", p.47-52, especially p.50, right column, line 14 to p.51 left column, line 40; Fig. 11	1-4
Y	Physical review B Vol.54, No.16 (1996), Shanhui Fan, Pierre R. Villeneuve, and J.D. Joannopoulos, "Large omni directional band gaps in metallodielectric photonic crystals", p.11245-11251	1-4
Y	Semicond Insul Mator 1996, D. Cassgne, C. Jouanin and D. Bertho, "Hexagonal structures for two-dimensional photonic crystals" p.341-344,	1-4
Y	NATO ASI SER E, 1996, D. Cassgne, C. Jouanin and D. Bertho, "Two-dimensional photonic band gaps: new hexagonal structures", p.497-505	1-4
A	JP, 62-289804, A (NEC Corporation), 16 December, 1987 (16.12.87), Full text ; all drawings (Family: none)	1-4
A	JP, 62-269104, A (NEC Corporation), 21 November, 1987 (21.11.87), Full text ; all drawings (Family: none)	1-4
A	JP, 10-59746, A (Nippon Ita Glass Co., Ltd.), 03 March, 1998 (03.03.98), Full text ; all drawings & WO, 9806676, A1	1-4
A	JP, 3-75705, A (Nippon Telegraph and Telephone Corp.), 29 March, 1991 (29.03.91), Full text ; all drawings (Family: none)	1-4
Y	JP, 4-36703, A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 06 February, 1992 (06.02.92), Full text ; all drawings (Family: none)	1-4
Y	JP, 61-17103, A (Canon Inc.), 25 January, 1986 (25.01.86), Full text ; all drawings (Family: none)	1-4
Y	JP, 5-215919, A (Matsuzaki Shinku K.K.), 27 August, 1993 (27.08.93), Full text ; all drawings (Family: none)	1-4
Y	JP, 61-262705, A (Fujitsu Limited), 20 November, 1986 (20.11.86), Full text ; all drawings (Family: none)	1-4

## A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl<sup>o</sup> G02B5/30, G02B5/18

## B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl<sup>o</sup> G02B5/30, G02B5/18

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1926-1996年

日本国公開実用新案公報 1971-1999年

日本国登録実用新案公報 1994-1999年

日本国実用新案登録公報 1996-1999年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

## C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	第58回応用物理学会学術講演会講演予稿集 (10月. 1997) 浜野哲子、井筒雅之、平山秀樹 「2次元フォトニック結晶を用いた偏光子の可能性」 paper 2a-W-7 (p993)	1-4
Y	電子情報通信学会論文誌, C-II, Vol. J80-C-II No. 6, (6月. 1997), 川上彰二郎 外4名, 「Si/SiO <sub>2</sub> 系サブミクロン周期3Dフォトニック結晶の作製 と観察」 P222-223	1-4
Y	JP, 9-304611, A (沖電気工業株式会社) 28. 11月. 1997 (28. 11. 97)	1-4

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

## \* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&amp;」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

01. 11. 99

国際調査報告の発送日

16.11.99

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

森内 正明

印

2V

9222

電話番号 03-3581-1101 内線 3269

C (続き) 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
	全文、全図 (ファミリーなし)	
Y	J. Vac. Sci. Technol. B Vol. 15, No. 6, Nov/Dec 1997, Chuan C. Cheng, Axccl Scherer, Ron-Chung Tyan, Yeshayahu Fainma n, George Witzgall, Eli Yablonovitch "New fabrication techniques for high quality phtonic crystals" P2764-2767, 特に P2764 右欄第 7 行-P2765 左欄第 5 行, Fig 1. in- plane 2D structure, P2766 左欄第 3 1 行-右欄第 5 行, Fig 4	1-4
Y	電子情報通信学会論文誌, C-I, Vol. J81-C-I No. 2, (2月. 1998), 川上彰二郎 外 2 名, 「バイアススパッタ法で作成された 3 D 周期ナノ構造の形成機構」 P 1 0 8-1 0 9	1-4
P, X	化学工業, (1月. 1999), 花泉修/川上彰二郎, 「フォトニック結晶とその応用」, P 4 7-5 2, 特に P 5 0 右欄第 1 4 行-P 5 1 左欄第 4 行, 図 1 1	1-4
Y	PHYSICAL REVIEW B Vol. 54, No. 16 (1996), Shanhui Fan, Pierre R. Villeneuve, and J. D. Joannopoulos, "Large omnidirectional band gaps in metallodielectric photon ic crystals", P11245-11251	1-4
Y	Semicond Insul Mator 1996, D. Cassgne, C. Jouanin and D. Bertho, "Haxagonal structures for two-dimensional photnic crystals", P341-344,	1-4
Y	NATO ASI SER E, 1996, D. Cassgne, C. Jouanin and D. Bertho, "TWO-DIMENSIONAL PHOTONIC BAND GAPS: NEW HEXAGONAL STRUCTURES ", P497-505	1-4
A	J P, 6 2-2 8 9 8 0 4, A (日本電気株式会社) 1 6. 1 2 月. 1 9 8 7 (1 6. 1 2. 8 7)	1-4
A	全文、全図 (ファミリーなし) J P, 6 2-2 6 9 1 0 4, A (日本電気株式会社) 2 1. 1 1 月. 1 9 8 7 (2 1. 1 1. 8 7)	1-4
A	全文、全図 (ファミリーなし) J P, 1 0-5 9 7 4 6, A (日本板硝子株式会社) 3. 3 月. 1 9 9 8 (0 3. 0 3. 9 8)	1-4
A	全文、全図 & WO, 9 8 0 6 6 7 6, A 1 J P, 3-7 5 7 0 5, A (日本電信電話株式会社) 2 9. 3 月. 1 9 9 1 (2 9. 0 3. 9 1)	1-4
Y	全文、全図 (ファミリーなし) J P, 4-3 6 7 0 3, A (松下電器産業株式会社) 6. 2 月. 1 9 9 2 (0 6. 0 2. 9 2)	1-4
Y	全文、全図 (ファミリーなし) J P, 6 1-1 7 1 0 3, A (キャノン株式会社) 2 5. 1 月. 1 9 8 6 (2 5. 0 1. 8 6)	1-4
Y	全文、全図 (ファミリーなし) J P, 5-2 1 5 9 1 9, A (松崎真空株式会社)	1-4

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	27. 8月. 1993 (27. 08. 93) 全文、全図 (ファミリーなし) JP, 61-262705, A (富士通株式会社) 20. 11月. 1986 (20. 11. 86) 全文、全図 (ファミリーなし)	1-4